

Физика и техника полупроводников, 2023, том 57, выпуск 9

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Титова А.М., Шенгуров В.Г., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Зайцев А.В., Алябина Н.А., Кудрин А.В., Здоровейщев А.В.

Гетероэпитаксиальные слои Ge/Si(001), легированные в процессе HW CVD испарением примеси из сублимирующего Ge-источника

719

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Алексеев П.А., Сахно Д.Д., Дунаевский М.С.

Трибоэлектрическая генерация при трении высоколегированных алмазных зондов о поверхность p-Si

725

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Бохан П.А., Журавлев К.С., Закревский Д.Э., Малин Т.В., Фатеев Н.В.

Механизмы оптического усиления в сильно легированных Al_xGa_{1-x}N:Si-структурах (x=0.56-1)

731

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Стручков А.И., Карабешкин К.В., Карасев П.А., Титов А.И.

Анализ параметров индивидуальных каскадов столкновений при облучении Ga₂O₃ и молекулярными ионами

738

Лебедев А.А., Малевский Д.А., Козловский В.В., Левинштейн М.Е.

Процессы долговременной релаксации в облученном протонами 4H-SiC

743

Углеродные системы

Золотовский И.О., Кадочкин А.С., Паняев И.С., Рожлейс И.А., Санников Д.Г.

Режим ганновской генерации в резонаторе на основе массива упорядоченных углеродных нанотрубок

751

Давыдов С.Ю., Посредник О.В.

Теоретические оценки фактора термоэлектрической мощности графена, капсулированного между 3D и 2D полупроводниковыми и металлическими слоями

758

Физика полупроводниковых приборов

Зубов Ф.И., Шерняков Ю.М., Бекман А.А., Моисеев Э.И., Салий (Гусева) Ю.А., Кулагина М.М., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Николаев А.В., Шерстнев Е.В., Максимов М.В.

Определение температуры и теплового сопротивления полудискового лазерного диода методом измерения импульсных вольт-амперных характеристик

767

Журавлев М.Н., Егоркин В.И.

Полевые р-канальные транзисторы на основе GaN/AlN/GaN-гетероструктуры на кремниевой подложке

773

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Березуцкий А.В., Микаелян Г.Т., Таривердиев С.Д.

Применение метода рентгеновской рефлектометрии для определения градиентов состава на границе квантовой ямы в лазерных структурах на основе системы AlGaAs/GaAs

779

Александров О.В.

Модель пробоя МОП-структур по механизму анодного освобождения водорода

784